

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波高利得増幅用

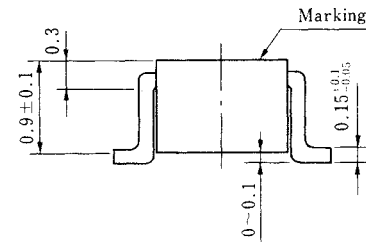
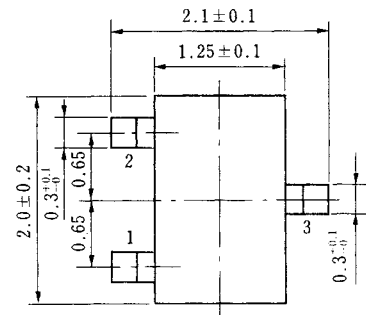
特 徴

- 超小形外形でありハイブリッドIC用として最適です。
- 直流電流増幅率が高い。
- h_{FE} : 600 TYP. ($I_C=1.0$ mA)
- 2SA1612とコンプリメンタリで使用できます。

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
全 損 失	P_T	150	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

外形図(単位: mm)



- 電極接続
1. エミッタ
 2. ベース
 3. コレクタ

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

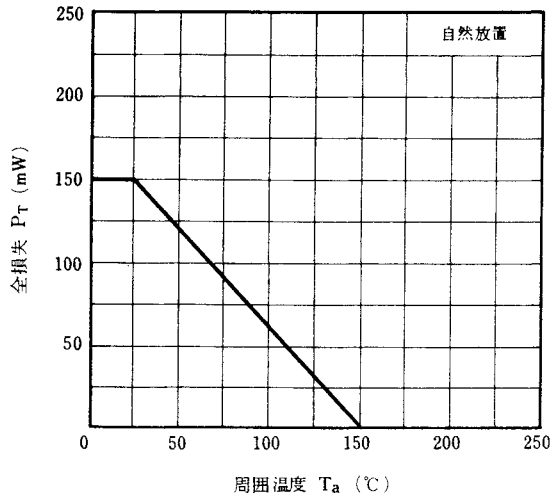
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=120$ V, $I_E=0$			50	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0$ V, $I_C=0$			50	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=6.0$ V, $I_C=0.1$ mA	100	580		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=6.0$ V, $I_C=1.0$ mA	135	600	900	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10$ mA, $I_B=1.0$ mA		0.07	0.3	V
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE}=6.0$ V, $I_C=1.0$ mA	550	590	650	mV
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=30$ V, $I_E=0$, $f=1.0$ MHz		1.6	2.5	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0$ V, $I_E=-1.0$ mA	50	110		MHz

h_{FE} 規格区分

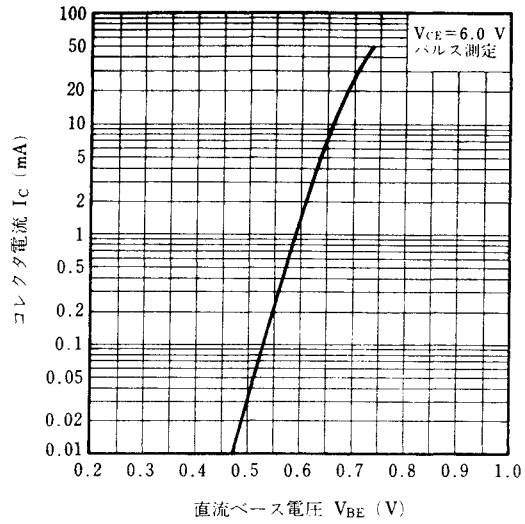
捺 印	D15	D16	D17	D18
h_{FE2}	135~270	200~400	300~600	450~900

特性曲線 (Ta = 25 °C)

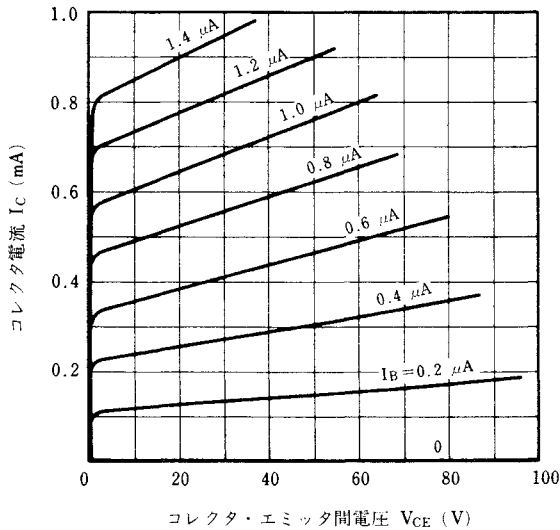
TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE



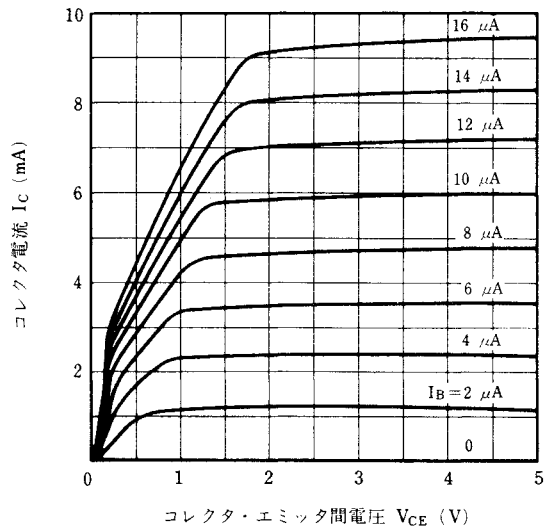
COLLECTOR CURRENT vs. BASE TO EMITTER VOLTAGE



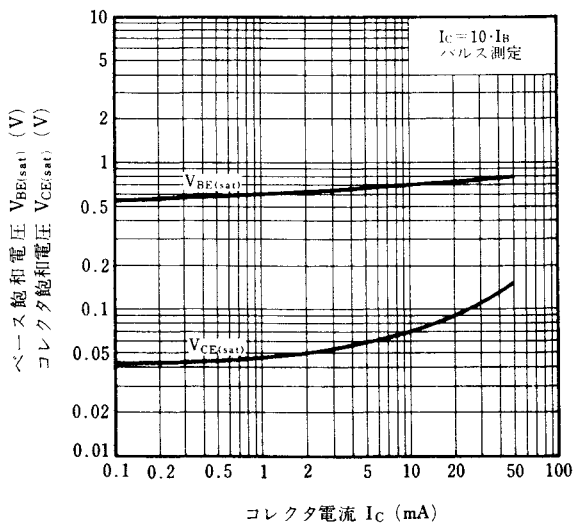
COLLECTOR CURRENT vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE



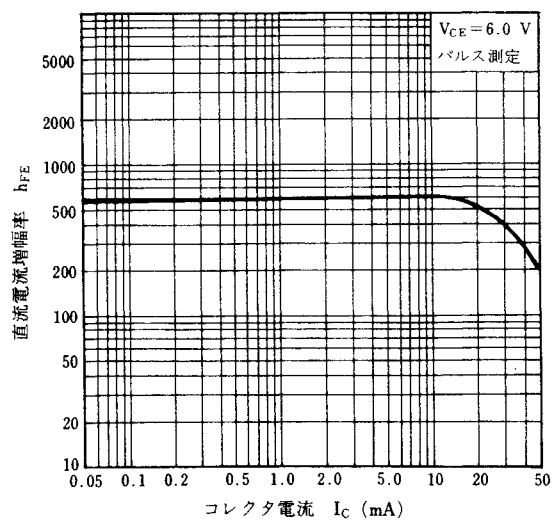
COLLECTOR CURRENT vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE



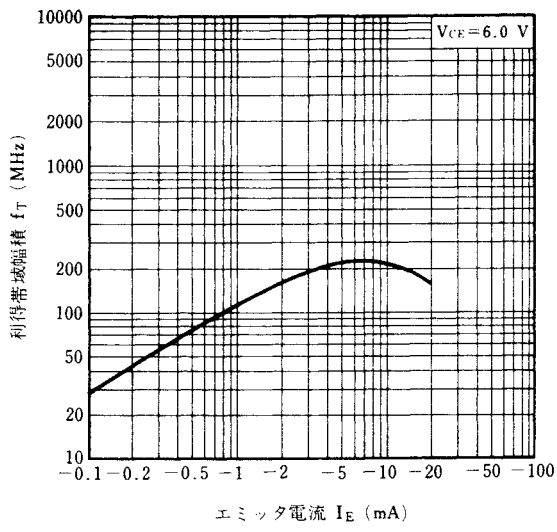
COLLECTOR AND BASE SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE

